

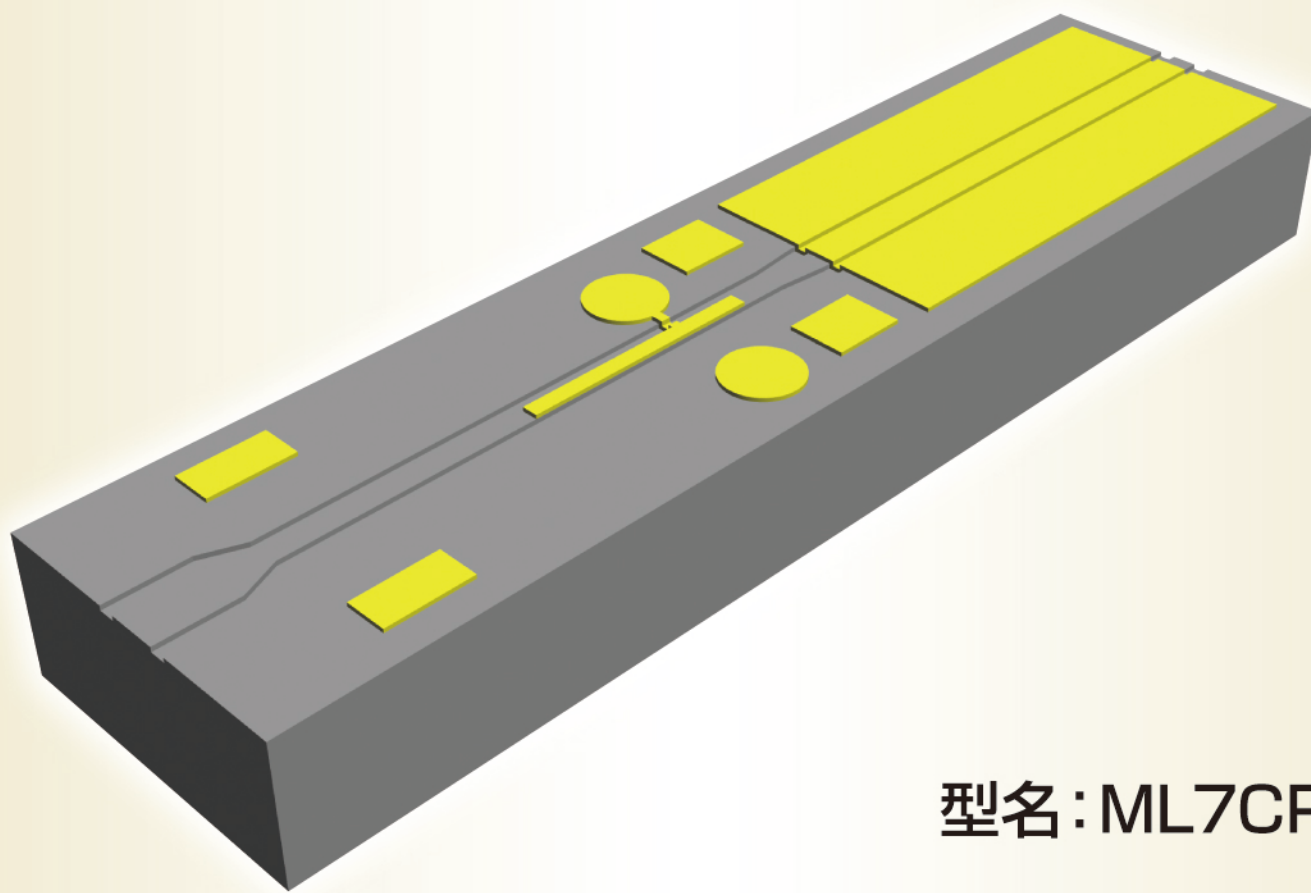
レーザー学会産業賞「優秀賞」受賞



広動作温度範囲 CWDM 100Gbps (53Gbaud PAM4) EML チップ



三菱電機株式会社



型名: ML7CP70

製品の特長

- 当社のEML (Electro-absorption Modulated Laser、EA変調器集積レーザー)は、放熱性に優れた埋込型の導波路構造のDFB (Distributed FeedBack) レーザーと、消光特性及び応答速度に優れたハイメサ型の導波路構造のEA (Electro-Absorption) 変調器を1つのチップ上に集積した独自のハイブリッド導波路構造を採用
- 独自のハイブリッド導波路構造により、レーザー部と変調器部をそれぞれ最適な導波路構造とすることで大幅な特性改善を実現し、5~85℃の広い動作温度範囲で優れた消光特性を有する100Gbps高速変調を実現

主な仕様

- 形名: ML7CP70
- 波長: 1271 / 1291 / 1311 / 1331 nm
- 動作温度範囲: 5℃~85℃
- 光変調振幅 (チップ端) : 5dBm以上, $V_{pp}=1.0V$
- 帯域: 35GHz以上

用途: 100Gbps通信用光送受信器